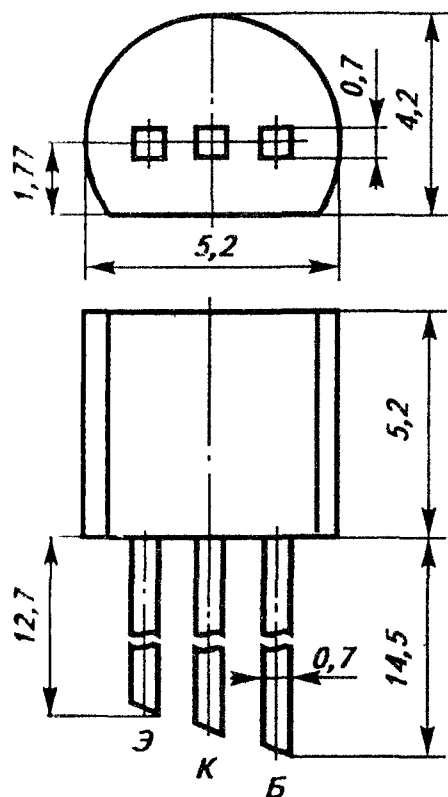


□ КТ684А, КТ684Б, КТ684В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры $n-p-n$ усилительные. Предназначены для применения в усилителях, генераторах, переключающих и импульсных устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Масса транзистора не более 0,3 г.



КТ684 (А-В)

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 2$ В,

$I_{э} = 150$ мА

КТ68А

40 250

КТ684Б, КТ684В

40 160

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 10$ В,

$I_{э} = 50$ мА,

не менее

40 МГц

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_{к} = 0,5$ А, $I_{б} = 0,05$ А

не более

0,5 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_{к} = 0,5$ А, $I_{б} = 0,05$ А,

не более

1,2 В

Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10$ В, не более

50 пФ

Обратный ток коллектора при $U_{кб} = U_{кб, макс}$, не более

100 нА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база

КТ684А

45 В

КТ684Б

60 В

КТ684В

100 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер

КТ684А

45 В

КТ684Б

60 В

КТ684В

100 В

Постоянное напряжение эмиттер-база

5 В

Постоянный ток коллектора

1 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора

0,8 Вт

Температура $p-n$ перехода

+150°C

Температура окружающей среды

45 +125°C